

Cerințe parțial 2
Dispozitive electronice**Teorie:**

1. TEC-J: structură, funcționare, simbol
2. TEC-J: Caracteristici statice de drenă
3. TEC-J: caracteristica de transfer și transconductanța
4. Polarizarea TEC-J: autopolarizare și polarizare cu divizor rezistiv
5. TEC-MOS cu canal inițial: structură, regimurile de funcționare, simboluri
6. TEC-MOS cu canal indus: structură, polarizarea pe poartă, simboluri
7. TEC-MOS cu canal inițial: caracteristica de transfer, transconductanța
8. TEC-MOS cu canal indus: caracteristica de transfer și transconductanța
9. TEC-MOS cu canal inițial: polarizarea la zero și cu divizor rezistiv
10. TEC-MOS cu canal indus: polarizare cu divizor de tensiune și cu reacție în drenă

Probleme:

1. cu TEC-J
2. cu TEC-MOS

Partial examination 2 requirements
Electronic Devices**Theory:**

1. JFET: structure, basic operation, symbol
2. JFET: drain characteristic curves
3. JFET transfer characteristic and forward transconductance
4. JFET biasing: self-bias and voltage-divider bias
5. D-MOSFET: structure, operation modes, symbols
6. E-MOSFET: structure, operation, symbol
7. D-MOSFET: transfer characteristic and forward transconductance
8. E-MOSFET: transfer characteristic and forward transconductance
9. D-MOSFET: zero-bias and voltage-divider bias
10. E-MOSFET: drain-feedback bias and voltage-divider bias

Exercises:

1. with JFET
2. with MOSFET